DOWER 10. 12/

19 BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**





DEUTSCHES PATENT- UND

MARKENAMT

② Aktenzeichen:

100 33 112.2-33

2 Anmeldetag:

7. 7.2000

4 Offenlegungstag:

24, 1, 2002

(3) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 14. 11. 2002

(B) Int. Cl.⁷: H 01 L 51/40 H 01 L 51/20 G 06 K 19/08

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

(73) Patentinhaber: Siemens AG, 80333 München, DE

(72) Erfinder:

Bernds, Adolf, 91083 Baiersdorf, DE; Clemens, Wolfgang Dr., 90617 Puschendorf, DE; Fix, Walter Dr., 90762 Fürth, DE; Rost, Henning Dr., 91056 Erlangen, DE

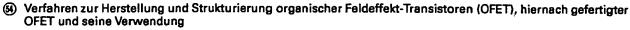
Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:

> 198 51 703 A1 DE DE 37 27 214 A1

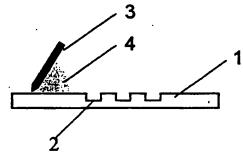
US 57 05 826

EP 786820A2

BAO, Z. et al.: "High-Performance Plastic Transistors Fabricated by Printing Techniques" in "Chem. Mater", 9 (1997) 6, pp. 1299-1301; GARNIER, F. et al.: "All-Polymer Field-Effect Transistor Realized by Printing Techniques" in "Science" 256 (1994), pp. 1684-1686; C.J. Drury et al.: "Low-cost all-polymer integrated circuits" in: "Applied Physics Letters*, 73 (1998) 1, pp. 108-110; M. Angelopoulos and J.M. Shaw: "In-Situ Radiation Induced Doping", in: "Mol. Cryst. Liq. Cryst.", 189 (1990), pp. 221-225;



Verfahren zur Herstellung eines organischen Feldeffekt-Transistors (OFET) durch Drucken von zumindest einem Funktionspolymer auf ein Substrat in einem Tampondruckverfahren, wobei das Funktionspolymer zu-nächst in eine mit herkömmlichen Druckfarben vergleichbare Konsistenz gebracht und dann auf das Substrat aufgedruckt wird.



BEST AVAILABLE COPY